



F.I.SH.: Jabbarova Bahor Olimbayevna

LAVOZIM: Katta o'qituvchi

TEJ: +99894 230 26 13

E – mail: bahorbahor1989@mail.ru

TASHKILOT TEL: +99862 2246700

TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon ko'chasi 14. 220100

DARAJASI	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 - 2012 Urganch davlat universiteti (bakalavr) • 2012 - 2014 yillarda O'zbekiston Milliy universiteti (magistr)
TAJRIBA	<ul style="list-style-type: none"> • 2014-2015 - Urganch davlat universiteti fizika kafedrası stajyor o'qituvchisi • 2021- Xozirgacha Urganch davlat universiteti fizika kafedrası o'qituvchisi
MUTAXASSISLIGI	<ul style="list-style-type: none"> • .Umumiy fizika (yo'nalishlar bo'yicha)
O'QITADIGAN FANLARI	<ul style="list-style-type: none"> • Umumiy fizika, molekulyar fizika, Fizpraktikum
TADQIQOT ISHI	<ul style="list-style-type: none"> • O'tishsiz nanoo'lchamli maydoniy tranzistorlarning o'z-o'zidan qizish effektiga texnologik fluktuatsiyalarning ta'sirini modellashtirish
TADQIQOTLARI	<ul style="list-style-type: none"> • M.M Khalilloev, B. O. Jabbarova A. A. Nasirov The Influence of Fin Shape on the Amplitude of Random Telegraph Noise in the Subthreshold Regime of a Junctionless FinFET //Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 12, pp. 1245–1248. • Халиллоев М.М., А.Э. Абдикаримов, З. Атамуратова, Б. Жаббарова, А.Э. Атамуратов. Короткоканальные эффекты в безпереходном МОП-транзисторе с различным уровнем легирования и формой базы//Республиканской научно-практической конференции участием зарубежных ученых «Инновационные технологии в науке и образовании». - Нукус. 20-21 ноября, 2018. - С. 106-107. • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя и бокового расширения затвора на пороговое напряжение в безпереходном МОП-транзисторе //Материалы международной конференции «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах». - Фергана. 25-26 мая, 2018.- С. 295-296 • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Сравнение амплитуды случайных телеграфных шумов в МОП транзисторах без переходов и с инверсионным каналом//«Современные проблемы физики полупроводников» СПФП-2019 –Нукус 20 ноября 2019 г. 82-86
HOZIRGI TADQIQOTLARI	<ul style="list-style-type: none"> • A.E.Atamuratov, B.O. Jabbarova, M.M. Khalilloev, A. Yusupov, A.G.J.Loureiro Self-heating effect in nanoscale SOI Junctionless FinFET with

